










	<h2 style="color: #E67E22;">SIRA52DP-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIRA52DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.SIRA52DP-T1-GE3.pdf  2.SIRA52DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA52DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.7 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	48W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7150pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIRA52DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA52DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA52DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIRA52DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA52DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA52DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA50DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V PWRPAK SO-8</p>	 <p>SIRA54DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A SO8</p>
 <p>SIRA58DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA58ADP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V</p>	 <p>SIRA36DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA50ADP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRA52DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIRA52DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA52DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA52DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIRA52DP-T1-GE3
SIRA52DP-T1-GE3 Electronic	SIRA52DP-T1-GE3-Komponenten	SIRA52DP-T1-GE3-Verteiler	SIRA52DP-T1-GE3-Bild	SIRA52DP-T1-GE3-Teil
SIRA52DP-T1-GE3 Preis	SIRA52DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA52DP-T1-GE3 Bild	SIRA52DP-T1-GE3 Aktie	SIRA52DP-T1-GE3 Inventar
SIRA52DP-T1-GE3 Neu	SIRA52DP-T1-GE3 Original	SIRA52DP-T1-GE3 garantiert	SIRA52DP-T1-GE3 RFQ	SIRA52DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited